

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

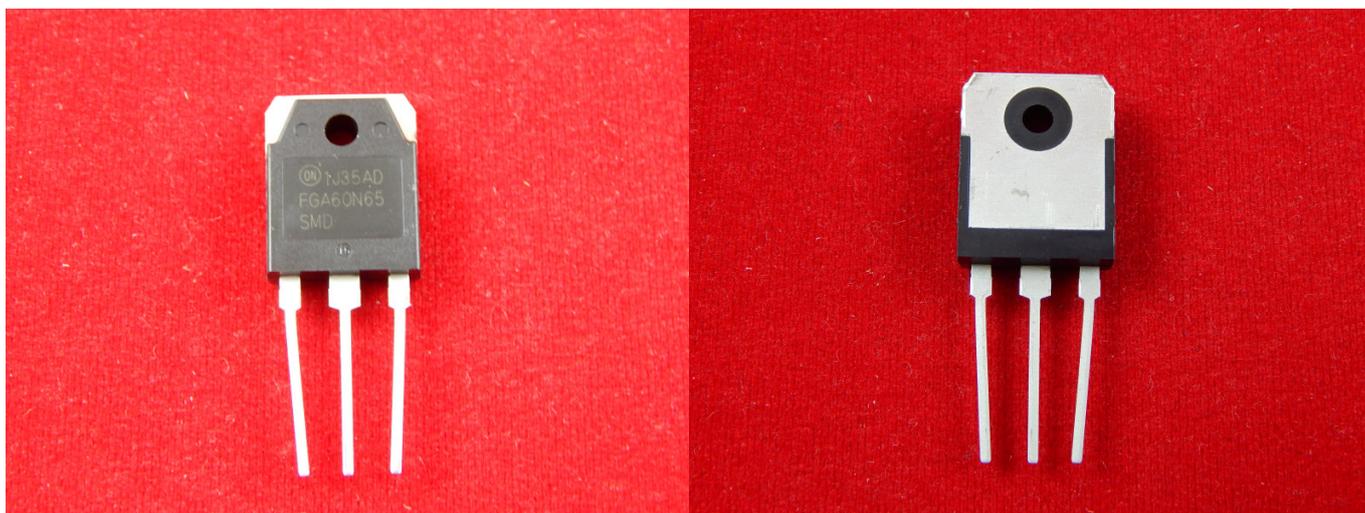
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15806

Цена в прайсе: 1265 тг.

FGA60N65SMD, биполярный транзистор IGBT, 650В, 120А, 600Вт



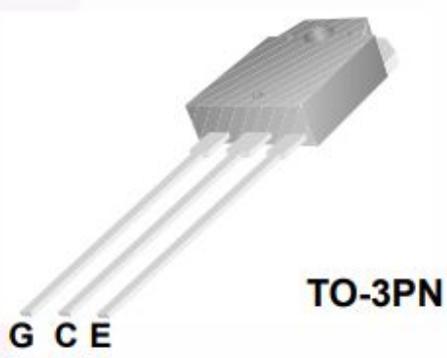
Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два р-п-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название биполярный.

Спецификация:

- Наименование: FGA60N65SMD;
- Тип управляющего канала: N-Channel;
- Максимальная рассеиваемая мощность: 600 W;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер: 650 V;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 2.5 V;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор: 20 A;
- Максимальный постоянный ток коллектора: 120 A;
- Максимальная температура перехода: 175°C;
- Время нарастания: 47 нс;
- Емкость коллектор: 270 pF;
- Рабочая температура: от -55°C до +175°C;
- Корпус: TO-3PN.

Структурная схема:



TO-3PN

